

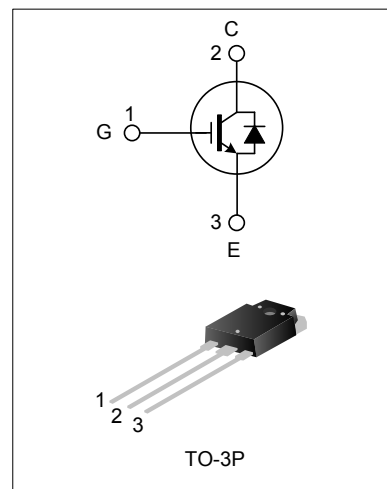
40A、600V绝缘栅双极型晶体管

描述

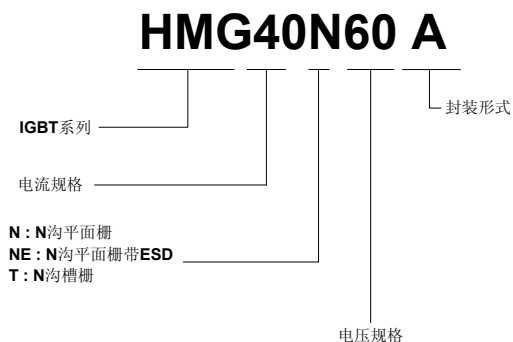
HMG40N60A 绝缘栅双极型晶体管采用新一代场截止(Field Stop)工艺制作, 具有低的导通损耗和开关损耗, 正温度系数易于并联应用等特点。该产品可应用于感应加热 UPS, SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- 40A, 600V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值})=1.8V@I_C=40A$
- 低导通损耗
- 超快开关速度
- 高击穿电压



命名规则



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	型 号	材 料	包 装
HMG40N60A	TO-3P	HMG40N60A	无铅	料管

极限参数 (除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	参数范围	单位
集电极-射极电压	V_{CE}	600	V
栅极-射极电压	V_{GE}	± 20	V
集电极电流	I_C	$T_C=25^{\circ}\text{C}$ 80	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$ 40	
集电极脉冲电流	I_{CM}	120	A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}\text{C}$)	P_D	290	W
- 大于 25°C 每摄氏度减少		2.32	W/ $^{\circ}\text{C}$
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻 (IGBT)	$R_{\theta JC}$	0.24	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对管壳热阻 (FRD)	$R_{\theta JC}$	1.4	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	35.5	$^{\circ}\text{C/W}$

IGBT 电性参数 (除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0V, I_C=250\mu A$	600	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=600V, V_{GE}=0V$	--	--	200	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$	--	--	± 500	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$	4.0	5.0	6.5	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=40A, V_{GE}=15V$	--	1.8	2.7	V
		$I_C=40A, V_{GE}=15V, T_c=125^{\circ}\text{C}$	--	2.1	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30V$	--	1850	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0V$	--	180	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	50	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=400V$ $I_C=40A$ $R_g=10\Omega$	--	18	--	ns
开启上升时间	T_r		--	80	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	110	--	
关断下降时间	T_f		--	105	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15V$	--	1.87	--	mJ
关断损耗	E_{off}	感性负载	--	0.68	--	
开关损耗	E_{st}		--	2.55	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE} = 300V, I_C=20A,$ $V_{GE} = 15V$	--	100	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	11	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	52	--	

FRD 电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{fm}	$I_F = 20A, T_c=25^{\circ}\text{C}$	--	1.9	2.6	V
		$I_F = 20A, T_c=125^{\circ}\text{C}$	--	1.5	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES} = 20A, dI_{ES}/dt = 200A/\mu s$	--	32	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_{ES} = 20A, dI_{ES}/dt = 200A/\mu s$	--	74	--	nC

典型特性曲线

图1. 典型输出特性

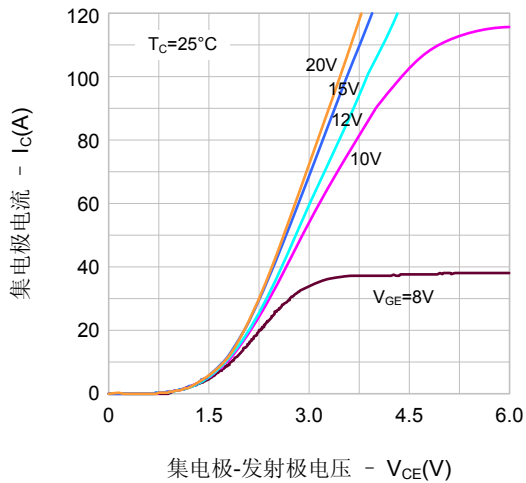


图2. 典型输出特性

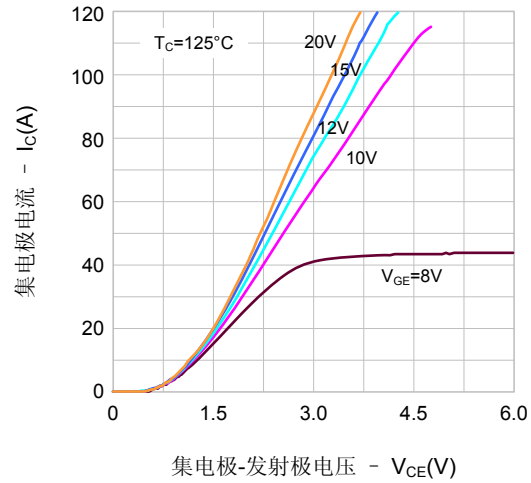


图3. 典型饱和电压特性

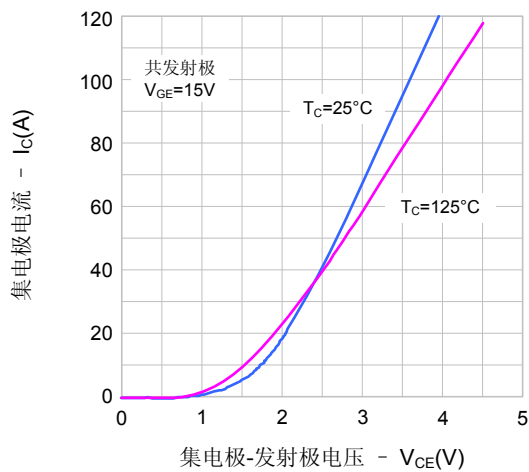


图4. 传输特性

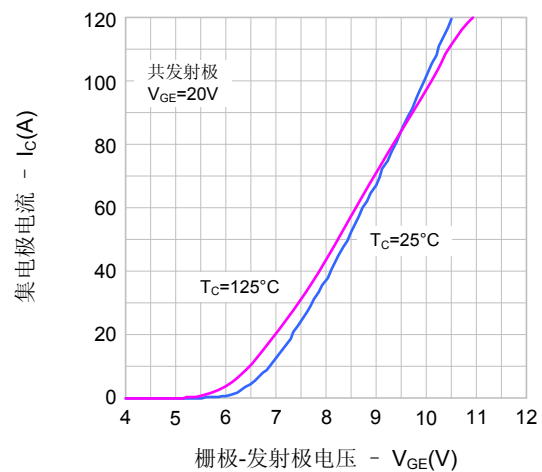


图5. 饱和电压 vs. Vge

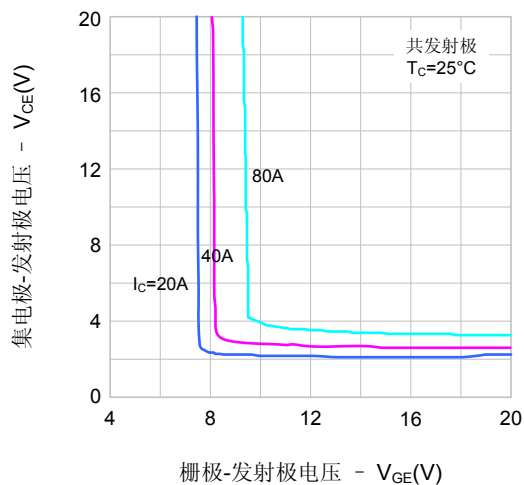
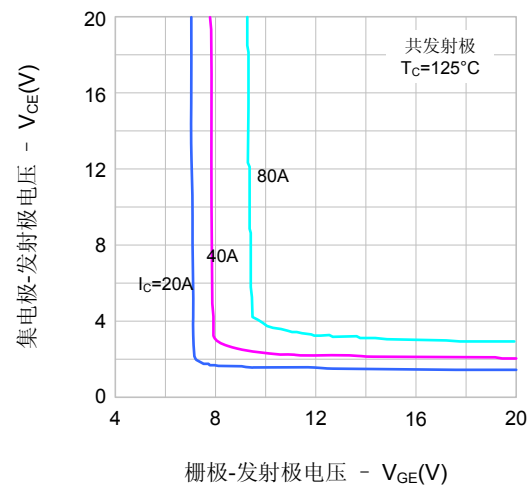


图6. 饱和电压 vs. Vge



典型特性曲线（续）

图7. 电容特性

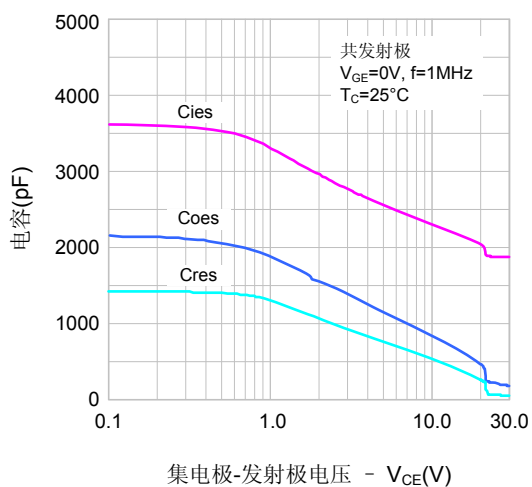


图8. 栅极电荷特性

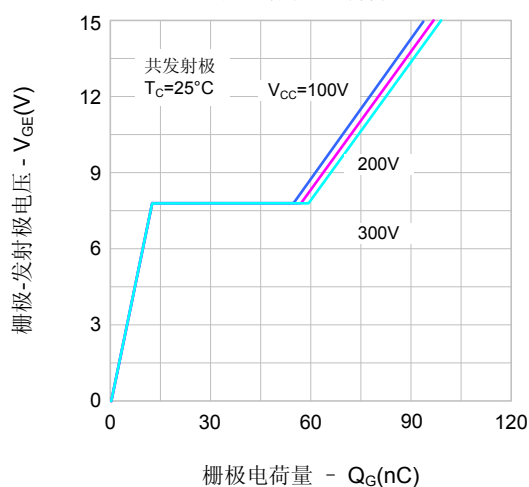


图9. 开启特性 vs. 栅极电阻

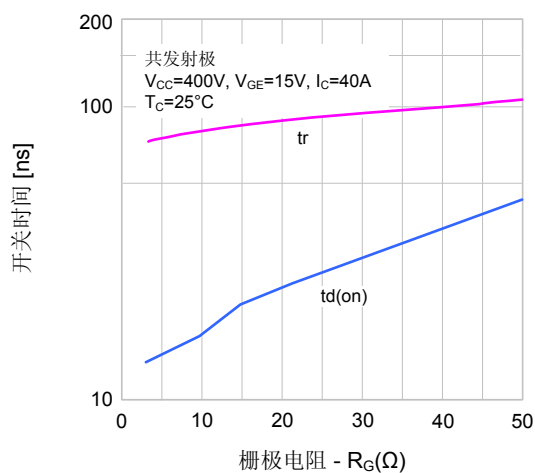


图10. 关闭特性 vs. 栅极电阻

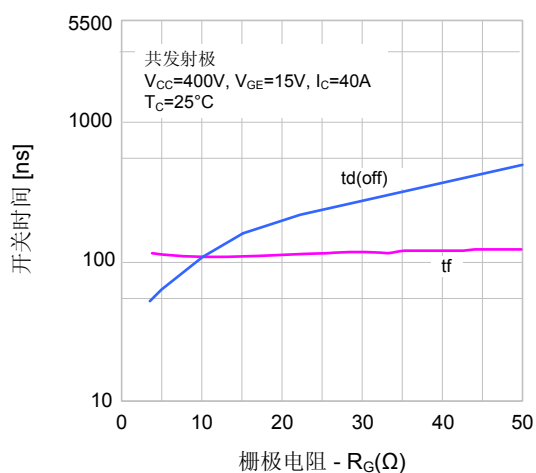


图11. 开关损耗 vs. 栅极电阻

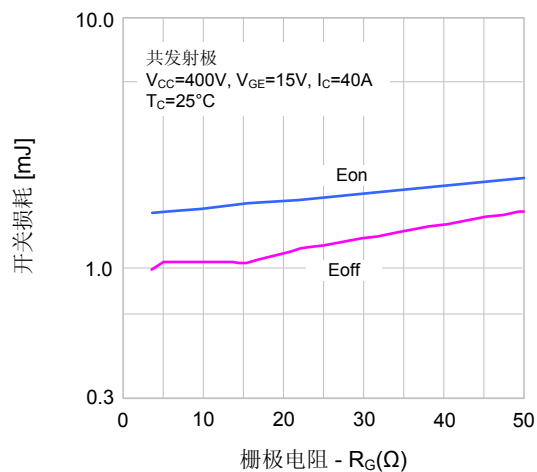
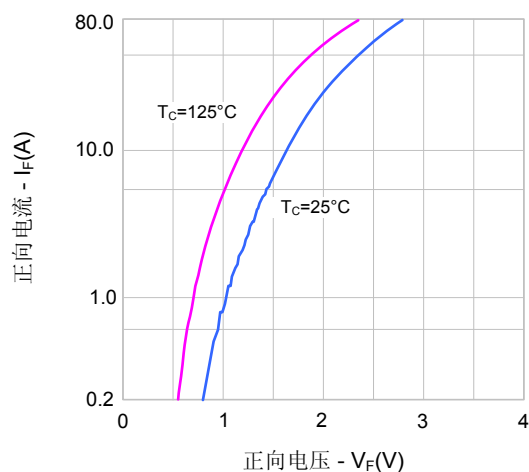


图12. 正向特性



典型特性曲线（续）

图13. SOA特性

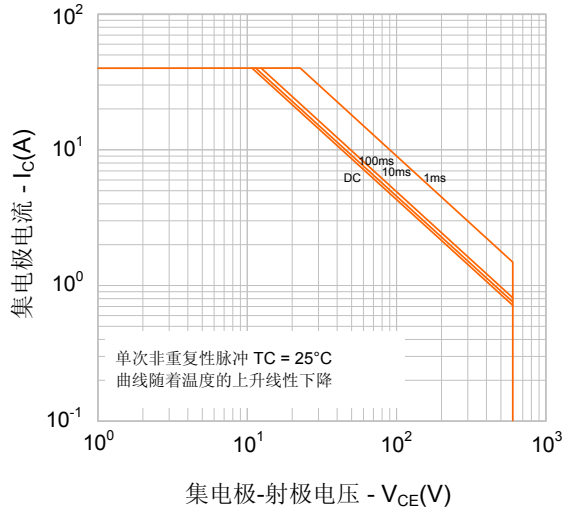
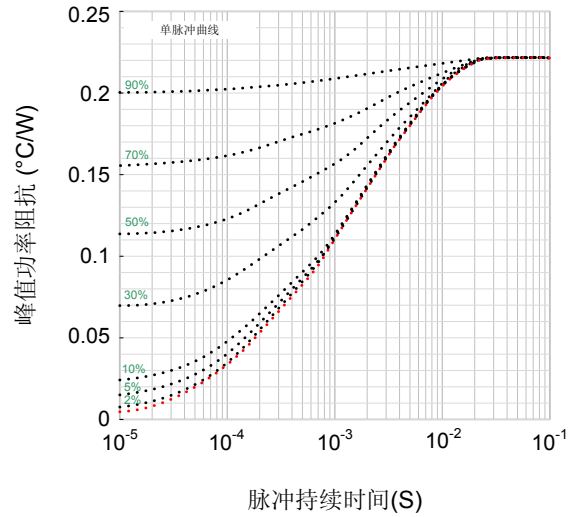


图14. IGBT瞬态热阻抗



封装外形图

TO-3P

单位: mm

